

Исследование униполярных транзисторов с изолированным затвором

Нехаев Александр, Остапив Алексей, Тихонов Сергей, Хавронин Михаил

Тип транзистора

НО n-МОПТ транзистор

Первый снимок

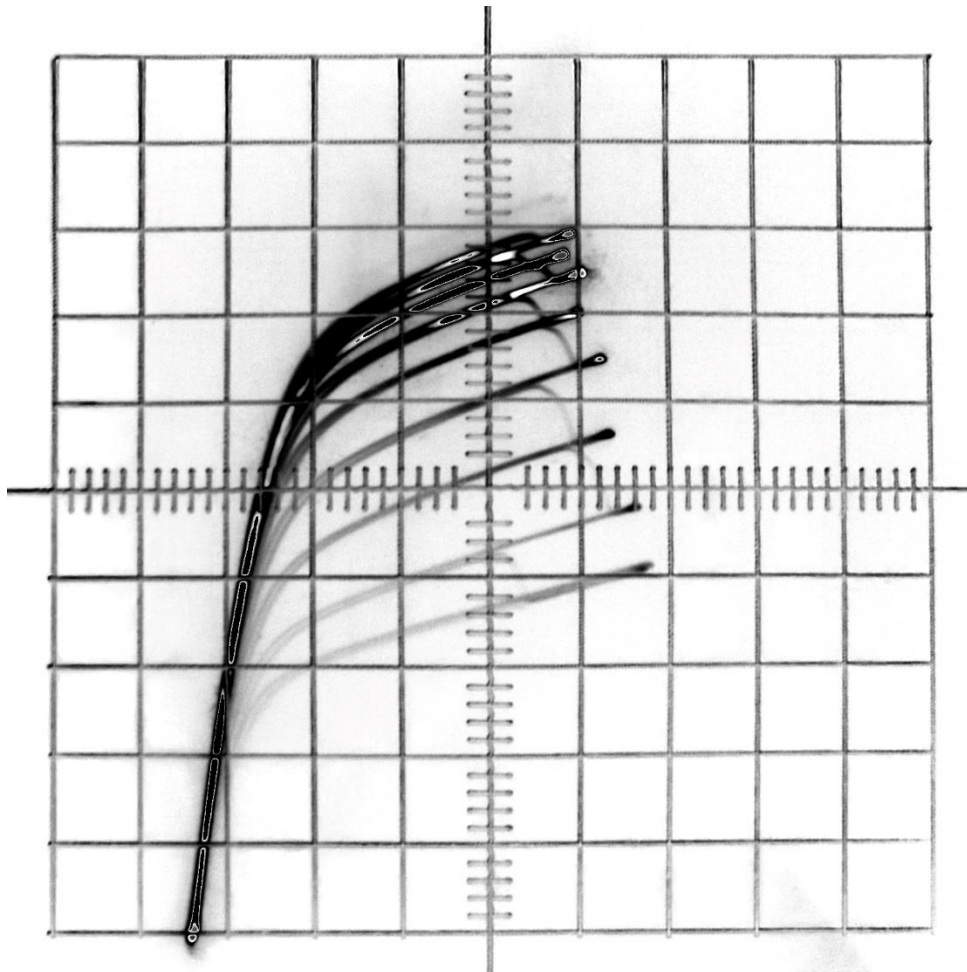
$$V_0 = 4 \text{ В}$$

$$I_0 = 5 \text{ мА}$$

$$x = +1 \text{ В}, y = +1 \text{ мА}, z = +0.2 \text{ В}$$

$$\text{Крутизна: } S \approx \frac{\Delta I_C}{\Delta V_3} = \frac{0.6 \text{ мА}}{0.2 \text{ В}} = 3 \text{ мА/В.}$$

Пороговое напряжение:



Второй снимок

$$x = +1 \text{ В}, y = +0.5 \text{ мА}, z = -0.2 \text{ В}$$

$$V_{\text{закр}} = -2.4 \text{ В}$$

